

# Silicon Diode

## **1P645**

225V / 400mA

# DATASHEET

OEM – ITT Intermetall

Source: ITT Intermetall Databook 73/74

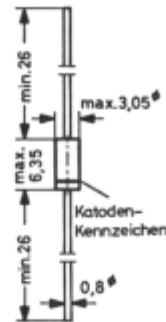
## 1 P 643... 1 P 647, 1 P 649

### Schnelle Silizium-Miniatur-Gleichrichter

Nennstrom 400 mA  
 period. Spitzensperrspannung 50...600 V

Kunststoffgehäuse  $3 \text{ } \varnothing \times 6,35$   
 56 A 2 nach DIN 41 883  
 Gewicht ca. 0,4 g  
 Maße in mm

In listenmäßiger Ausführung werden diese Gleichrichter gegurtet geliefert. Näheres siehe unter „Gurtung“.



### Grenzwerte

Typ	periodischer Spitzensperrspannung $U_{RRM}$ V
1 P 643	50
1 P 644	100
1 P 645	225
1 P 646	300
1 P 647	400
1 P 649	600

periodischer Spitzenstrom bei $\theta < 40^\circ, f > 15$ Hz	$I_{FRM}$	2 1)	A
Stoßstrom für eine 50-Hz-Sinus-halbwellen ausgehend von $T_J = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	15	A
Sperrschichttemperatur	$T_J$	150	$^\circ\text{C}$
Betriebs- und Lagerungstemperaturbereich	$T_U, T_S$	-55...+150	$^\circ\text{C}$

1) Dieser Wert gilt, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse Umgebungstemperatur gehalten werden.

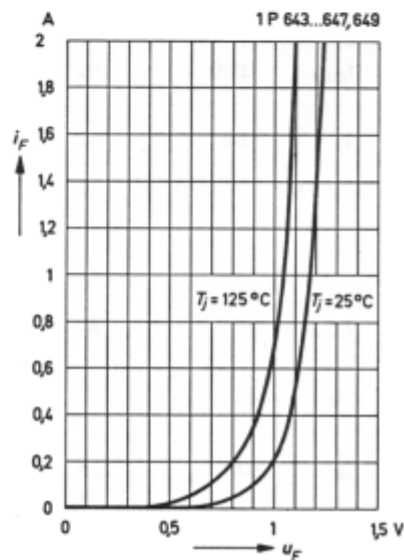
# 1 P 643...1 P 647, 1 P 649

## Kennwerte

Nennstrom bei $T_U = 45\text{ °C}$	$I_{FAV}$	400 1)	mA
Durchlaßspannung bei $I_F = 1\text{ A}$ , $T_j = 25\text{ °C}$	$U_F$	<1,5	V
Sperrstrom bei $U_{RRM}$ und $T_j = 25\text{ °C}$	$I_R$	<5	$\mu\text{A}$
Sperrverzug beim Umschalten von $I_F = 10\text{ mA}$ auf $I_R = 10\text{ mA}$ bis $I_R = 1\text{ mA}$	$t_{rr}$	<500	ns
Wärmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft	$R_{thU}$	<601)	K/W

1) Dieser Wert gilt, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.

## Durchlaßkennlinien



## zulässiger Richtstrom in Einwertschaltung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur

